智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第38號

原　　告　家登精密工業股份有限公司
代　表　人　邱銘乾（董事長）
訴訟代理人　郭雨嵐律師
　　汪家倩律師
　　潘皇維律師
輔　佐　人　陳建銘
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　楊淑珍
　　周志浩
參　加　人　美國安堤格里斯公司
代　表　人　Arlene Hornilla（副總裁、代理法務長兼首席智慧財產顧問）
訴訟代理人　張哲倫律師
　　陳初梅律師
　　陳佳菁律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國108 年3 月27日經訴字第10806302250 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院依職權命參加人獨立參加被告訴訟，判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。行政訴訟法第111條第1 項定有明文。原告起訴聲明第1 項為：「原處分『請求項2 、5 至7 舉發成立，應予撤銷。』之部分及訴願決定均撤銷。」（見本院卷1 第13頁），嗣於民國108 年7 月2日具狀變更聲明第1 項為：「訴願決定及原處分關於『請求項5 至7 舉發成立，應予撤銷』之部分均撤銷。」（見本院卷1 第81頁），核原告上開所為，係減縮其訴之聲明，且經被告及參加人當庭同意在卷（見本院卷1 第425 頁），揆諸前揭規定，尚無不合，應予准許。

二、事實概要：

原告前於103 年9 月24日以「具有標記之極紫外光光罩盒」向被告申請新型專利，申請專利範圍共7 項，經被告編為第000000000 號進行形式審查准予專利後，發給新型第M496146 號專利證書（下稱：系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第104 條、第120 條準用第26條、第22條第1 項第1 款及第2 項之規定，對之提起舉發。原告則於107年1 月11日及25日提出系爭專利更正本，請求刪除說明書之贅字及系爭專利請求項1 、3 、4 ，並將請求項5 改寫為獨立項。案經被告審查，認其更正符合規定，乃准予更正並依該更正本審查，惟認為更正後系爭專利違反前揭專利法第120 條準用第22條第1 項第1 款及第2 項規定，以107 年9 月21日（107 ）智專三（五）01103 字第10720885520 號專利舉發審定書為「107 年1 月11及25日之更正事項，准予更正」、「請求項2 、5 至7 舉發成立，應予撤銷」、「請求項1 、3 至4 舉發駁回」之處分。原告不服原處分關於舉發成

立部分，提起訴願，經經濟部以108 年3 月27日經訴字第10806302250 號決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。惟本件判決結果，倘認訴願決定及原處分關於舉發成立部分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受有損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

三、原告起訴主張：（一）參加人所提參證1 號係為主張系爭專利請求項所述雷射雕刻、該標記反射光線、產生電壓值（訊號）等技術特徵，為教科書所列之通常知識，依最高行政法院108 年度判字第211 號判決意旨，自屬於智慧財產案件審理法（下稱：審理法）第33條之新證據，而參加人「非」屬審理法第33條第1 項之當事人，不得於行政訴訟階段提出該參證1 號之新證據。（二）原處分並無審酌證據2 、3 、4 之技術內容，是否揭示系爭專利請求項5 之技術特徵，由原處分書第11頁第18至22行記載內容，被告肯認證據1 「未」揭示系爭專利請求項5 「該至少一標記係利用雷射雕刻方式形成於該光罩盒體」之技術特徵，故證據1 至4 均未揭示系爭專利請求項5 「該至少一標記係利用雷射雕刻方式形成於該光罩盒體」之技術特徵。又系爭專利提供一種具有標記之極紫外光光罩盒，該標記係利用雷射雕刻方式形成於該光罩盒而具有一表面粗糙度，可依使用人之需求利用雷射雕刻方式控制表面粗糙度，藉以影響該光罩盒之反射光所產生之電壓值，利用光線照射於該光罩盒上之該標記後，再反射回來之光線產生之電壓值之標準差能控制於一定範圍內；反之，光線如未精確對應照射至該標記，則再反射回來之光線產生之電壓值之標準差無法穩定落在設定的數值範圍內，進而達到使微影機台能夠精準辨識該光罩盒是否位於正確位置之目

的。相較於證據1 所揭示之光學影像辨識技術角度觀之，因影像辨識技術本就無須考量被拍攝物之加工方式及粗糙度，遑論揭示粗糙度是否可使感測器偵測到的電壓值之標準差能控制於一定範圍內等功效。至於證據2 至4 均與定位光罩盒領域無涉，故系爭專利請求項5 所載「該至少一標記之表面粗糙度介於0um 到2.00um之間」之技術特徵，具有無法預期之功效。（三）系爭專利請求項6 係依附於請求項5 ，並進一步界定「其中該至少一標記之反射後之該光線所產生之電壓值介於4.80伏特與5.20伏特之間」之技術特徵，因該等技術特徵隱含「標記」具有適用於電壓值介於4.80伏特與5.20伏特間的特定數值範圍之「表面粗糙度」，將該改變或影響系爭專利請求項6 之結構，故該等技術特徵自有限定作用，而非習知技術之運用。（四）系爭專利請求項7 係依附於請求項5 ，並進一步界定「其中該至少一標記之反射後之該光線所產生之電壓值在3-sigma 等級規範下之標準差浮動控制於0.1 以內」之技術特徵，該等技術特徵均隱含「標記」具有適用於電壓值在3-sigma 等級規範下之標準差浮動控制於0.1 以內之「表面粗糙度」，將該改變或影響系爭專利請求項7 之結構，故該等技術特徵自有限定作用，而非習知技術之運用等語。求為判決訴願決定及原處分均撤銷。

四、被告則以：（一）依系爭專利說明書【0010】記載「……其至少一標記透過雷射雕刻方式形成於光罩盒體，以改變對應加工機台之至少一感測器的極紫外光光罩盒之至少一區域的表面粗糙度，使一光線受到至少一標記反射後之反射光所產生之電壓值維持一定範圍內」，可見系爭專利利用雷射雕刻方式，僅是為形成特定表面粗糙度，而非特定表面形貌，且

系爭專利請求項5 已具體界定表面粗糙度範圍，該「利用雷射雕刻方式」之敘述，已然無法產生「表面粗糙度介於0um到2.00um」以外之結構特徵，因此，應認定「利用雷射雕刻方式」屬不影響結構之非結構特徵。又證據1 雖未具體揭示測十字型標記之表面粗糙度，惟系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，基於系爭專利申請時光罩盒技術領域之通常知識（如：光罩盒之尺寸、微影裝置等），以及證據1 揭示「光學顯微鏡」攝像方法，即可推知證據1 之十字型標記應為一微細結構，依申請時之通常知識，形成微細結構之方式無非印製、雷射刻記等精密微結構工法，其表面應為趨於平整，系爭專利之極紫外光光罩盒實無法具體區隔與證據1 標線載體3 之差異，換言之，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1 揭示之內容即可完成系爭專利之新型，原處分認定系爭專利不具進步性，並無違法。（二）原告主張系爭專利請求項6 、7 進一步界定之電壓值範圍，影響標記之表現粗糙度，具有限定作用云云。惟查，系爭專利所稱之電壓值，係由入射光線、表面粗糙度所決定，並無電壓值影響表面粗糙度之理，原處分認定前述請求項進一步界定之電壓值對結構未產生影響，並無違法等語，資為抗辯。求為判決駁回原告之訴。

五、參加人陳述略以：（一）參證1 是為了回應原告提出專家意見書（甲證3 ），而對於通常知識的補充說明文件，並非審理法第33條所規定的新證據。（二）粗糙度僅是一物理性的度量名詞，粗糙度之大小僅表示一有高低起伏的區域中整體性平均的高低差的大小，而無法反映該區域中高低起伏（表面形貌）之實況。又系爭專利說明書並無任何因雷射雕刻產

生之標記之可產生何種「表面形貌」之描述，顯然標記本身的表面形貌如何，並非系爭專利所關注並請求保護之結構特徵。再者，系爭專利說明書與圖式並沒有揭露其利用「雷射雕刻」及「標記反射後產生的電壓值」之方式造成任何不同於前案的「細部結構」特徵，而僅是與前案相同地利用以雷射或其他方式產生一有粗糙度之標記然後以光學檢知方式測得該標記之位置而已，故原告所稱「雷射雕刻」及「標記反射後產生的電壓值」會影響半導體領域光罩盒結構特徵之說詞，無任何憑據。此外，系爭專利或原告書狀並未解釋如何具體地使量測得到之「電壓值」對於標記之表面粗糙度產生限定作用，且證據4 亦已敘及系爭專利所敘述之將測得的反射光轉成電子訊號之轉換，「該至少一標記反射後之該光線所產生之電壓值係依據該至少一標記之表面粗糙度」確為習知技術，僅證據1 即可以認定系爭專利請求項5 不具進步性。縱然需要考慮先前技術是否確實揭露以「雷射雕刻」形成「標記」之技術應用，此已為證據2 所揭露。又縱認需要參考揭露「該至少一標記反射後之該光線所產生之電壓值係依據該至少一標記之表面粗糙度」之先前技術，證據3 亦已實質隱含或揭露該技術特徵，另「標記之表面粗糙度介於0um到2.00um之間」之特徵，亦為證據4 所揭露。（三）系爭專利請求項6 依附於請求項5 ，其技術特徵僅較請求項5 增加「該至少一標記之反射後之該光線所產生之電壓值介於4.80伏特與5.20伏特之間」之「非結構特徵」，於考量請求項6之進步性時，該非結構特徵應視為習知技術之運用，無庸於引證文件中有所揭露。（四）系爭專利請求項7 依附於請求項5 ，其技術特徵僅較請求項5 增加「該至少一標記之反射

後之該光線所產生之電壓值在3-sigm a等級規範下之標準差浮動控制於0.1 以內」之「非結構特徵」，蓋所謂的3-sigm a 等級規範下之標準差控制僅是指品質控制上的良率/ 不良率反映在統計值上的表現，與結構無關。非結構特徵應視為習知技術之運用，無庸於引證文件中有所揭露等語，資為抗辯。求為判決駁回原告之訴。

六、法律適用：

按新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定，專利法第119 條第3 項本文定有明文。查系爭專利申請日為103 年9 月24日，經被告審查後於103 年11月19日核准專利，嗣參加人於106 年9 月22日提出舉發，經被告審查，於107 年9 月21日作成原處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准處分時所適用之103 年1 月22日修正公布，103 年3 月24日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。

七、本件審理之爭點：

（一）系爭專利申請專利範圍共7 項，其中請求項1 、5 為獨立項，其餘為附屬項。參加人對系爭專利提起舉發案，包含下述（三）2.等共計8 項舉發事由（見審定書第5-6 頁，本院卷1 第21-22 頁），原告則於舉發審查程序之107 年1 月11日提出專利說明書更正本，復於同年月25日提出刪除公告請求項1 、3 、4 更正本（見舉發卷第79-80 、83-84 頁）。案經被告審查，107 年1 月11日專利說明書更正本與原公告本相較，係將公告說明書第【0018】段第3行「標記標記」及第【0020】段第10行「與」等前贅語（字）刪除，屬「誤記之訂正」；107 年1 月25日申請專利範圍更正本，係刪除原請求項1 、3 、4 ，屬「請求項之

刪除」；於請求項5 引入原依附請求項1 、3 、4 之技術特徵而改寫為獨立項，引入之技術特徵均可對應於申請時說明書內容，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且仍可達成更正前之創作目的，故未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第120條準用第67條第1 項第1 款、第3 款、第2 項及第4 項之規定，而為「107 年1 月11及25日之更正事項，准予更正」之處分。

（二）被告依107 年1 月11及25日之更正事項予以審查後，認證據1 可證明系爭專利請求項2 違反核准審定時專利法第120 條準用第22條第1 項第1 款、第22條第2 項規定，而不具新穎性及進步性（即舉發爭點4-5 ，見處分書第6 頁，本院卷1 第22頁），及下述（三）2.之舉發事由（即舉發爭點6-8 ，見處分書第6 頁，本院卷1 第22頁），可證明系爭專利請求項5-7 違反核准審定時專利法第120 條準用第22條第2 項規定，不具進步性，其餘舉發事由，均無法證明系爭專利請求項2 、5-7 不具進步性，而作成上開「請求項2 、5 至7 舉發成立，應予撤銷」之處分。嗣原告於本件訴訟程序中，除下述（三）1.之事項外，另僅爭執原處分中關於請求項5 至7 舉發成立部分之適法性（見本院卷1 第423-425 頁）。故本件僅針對被告依下述（三）2.之舉發事由，作成「請求項5 至7 舉發成立，應予撤銷」部分之處分，是否有所違誤予以判斷。

（三）爭點內容（見本院卷1 第435-437 頁）：

1.參證1 是否為審理法第33條所稱之新證據？

2.證據1 、2 之組合；證據1 、2 、3 之組合；證據1 、2

、4 之組合，是否可以證明系爭專利請求項5-7 不具進步性？

八、得心證之理由：

（一）按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准時專利法第104 條及第120 條準用第22條第1 項所規定。又新型專利如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得新型專利；新型有違反同法第120 條準用第22條規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發之，復為同法第120 條準用第22條第2 項、同法第119 條第1項所明訂。準此，系爭專利請求項5-7 有無違反核准時專利法第120 條準用第22條第2 項所定情事而應撤銷其專利權，任何人得檢附證據，向專利專責機關即被告提起舉發，倘舉發人即本件參加人所附之證據可以證明系爭專利違反上開專利法規定而不具進步性，自應為舉發成立之處分。

（二）次按，由於判斷專利有無進步性之相關事實，往往涉及專門知識，而專利權人、舉發人或其等訴訟代理人、專利專責機關之代理人等，多係具有發明所屬技術領域之相關知識或技能者，是以當事人就「具有通常知識者」及其於申請日之技術水準之認定加以爭執時，自應提出證據加以證明，並具體指明該事實涵攝於個案之先前技術組合後，對於進步性之決定究有何影響。如當事人已於事實審就系爭專利與舉發證據所揭露之內容間有何差異，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成

申請專利之發明加以辯論，應認當事人已就該發明所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論（最高行政法院106 年度判字第651 號判決意旨參照）。查本件當事人已於本院就系爭專利與舉發證據所揭露之技術內容間有何差異，以及參酌上開技術內容，是否能輕易完成系爭專利之發明進行辯論，本判決並據以說明系爭專利不具進步性決定之理由（詳如後述），揆諸前揭判決意旨，應認當事人已就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論，先予敘明。

（三）系爭專利技術內容（相關圖式：附圖1 ）：

1.系爭專利係有關於一種具有標記之極紫外光光罩盒（EUV Pod ），其包含一光罩盒體與至少一標記，該至少一標記設置於該光罩盒體，並利用一加工機台之至少一感測器辨識該至少一標記。本創作之極紫外光光罩盒透過該至少一標記之設置，改變可被該至少一感測器辨識之該光罩盒體的至少一區域之表面粗糙度，然該至少一感測器發出一光線至該光罩盒體，該光罩盒體反射該光線到該至少一感測器，該至少一感測器接收該光罩盒體所反射之光線，並判斷反射後之該光線所產生之電壓是否落於該標記之反射範圍內，以確定該至少一感測器已對應該至少一標記（參系爭專利新型摘要，見申請卷第12頁）。

2.系爭專利申請專利範圍：更正公告後系爭專利請求項共計4 項，其中請求項5 為獨立項，請求項6 、7 為直接依附請求項5 之附屬項（見舉發卷第71頁）；又更正後雖未刪除請求項2 ，並經原處分認定請求項2 舉發成立

，應予撤銷，然其為依附於已刪除之請求項1 之附屬項，且原告於本件並未就請求項2 舉發成立之部分為爭執，業如前述，故以下僅針對爭執之請求項5-7 為技術分析：

請求項5 ：一種具有標記之極紫外光光罩盒，其包含：一光罩盒體；以及至少一標記，其設置於該光罩盒體；其中該光罩盒體放入一加工機台，該加工機台之至少一感測器辨識該至少一標記；該至少一標記係利用雷射雕刻方式形成於該光罩盒體，該至少一標記具有一表面粗糙度，該至少一標記之表面粗糙度介於0um 到2.00um之間，該加工機台之該至少一感測器產生一光線，該光線照射該至少一標記，該至少一標記反射該光線，該至少一標記反射後之該光線所產生之電壓值係依據該至少一標記之表面粗糙度。

請求項6 ：如申請專利範圍第5 項所述之具有標記之極紫外光光罩盒，其中該至少一標記之反射後之該光線所產生之電壓值介於4.80伏特與5.20伏特之間。

請求項7 ：如申請專利範圍第5 項所述之具有標記之極紫外光光罩盒，其中該至少一標記之反射後之該光線所產生之電壓值在3-sigma 等級規範下之標準差浮動控制於0.1 以內。

（四）參加人主張系爭專利請求項5-7不具進步性，其引用之舉發證據為證據1-4 及其組合，茲就舉發證據1-4 之技術內

容，分析如下：

1.證據1（相關圖式：附圖2）：

－證據1 為西元2012年8 月9 日公開之US2012/0000000A1 「十字標記保護構件、十字標記運送裝置、曝光裝置以及十字標記運送方法」專利案，其公開日早於系爭專利申請日（103 年9 月24日），可為系爭專利相關之先前技術。

—證據1 提供一種位置量測裝置量測形成於一光罩下表面之一位置量測標記之位置，藉此量測該光罩之位置。一位置量測裝置量測形成於一下蓋之下表面之位置量測標記之位置，藉此偵測該下蓋之位置。當得知該光罩之位置與該下蓋之位置時，也就得知該光罩及下蓋之相對偏移量。因此，當裝載有該光罩於其上之該下蓋被一載運裝置所載運並被置入一曝光裝置中時，該下蓋之停放位置即可藉由考量該相對偏移量而確知。因此，該光罩可被正確地放置於該曝光裝置中（見舉發卷第38頁；中文譯文，見本院卷2第21頁）。

2.證據2（相關圖式：附圖3）：

－證據2 為西元2009年4 月9 日公開之US2009/0000000A1「用於檢查光罩基底的設備和方法，製造反射曝光光罩的方法，反射曝光的方法以及製造半導體積體電路的方法」專利案，其公開日早於系爭專利申請日（103 年9 月24日），可為系爭專利相關之先前技術。

—證據2 揭示光罩基底片檢知裝置係由下列元件所構成：一用於承載一反射式光罩基底片之載台，一用以產生檢知光的光源，一用來作為光學照亮之鏡，一取像

光學系統，一分光鏡，兩個二維陣列感測器，信號儲存單元，一影像處理單元，一用以控制整體裝置操作之主要控制單元，位於一位置之第一感測器，該位置係與一第一光線之該聚焦平面相隔一預設距離，位於一位置之第二感測器，該位置係與一第二光線在沿一相反方向的該聚焦平面相隔一預設距離；藉此，該裝置可正確而便利地檢知反射式光罩基底片之存在或不存在以及光罩基底片上的缺陷之類型（見舉發卷第28頁；中文譯文，見本院卷2第27頁）。

3.證據3（相關圖式：附圖4）：

－證據3 為西元2006年1 月12日公開之US2006/0000000A1「對準標記和微影設備以及使用其的裝置製造方法」專利案，其公開日早於系爭專利申請日（103 年9月24日），可為系爭專利相關之先前技術。

—證據3 揭示了一裝置，其包含一第一支撐結構，該第一支撐結構配置以支撐一具有一對位標記之元件，該對位標記具有至少一高度差。該裝置亦具有一對位感測器，其包含一光源，該光源配置以提供照亮該對位標記之一光線；及至少一偵測器配置以偵測該對位標記之該至少一高度差，偵測方式係藉由分析由該對位標記所反射之該光線。此一裝置可被用於該元件相對於該第一支撐結構之對準（見舉發卷第18頁；中文譯文，見本院卷2 第30頁）。

4.證據4（相關圖式：附圖5）：

－證據4 為西元2012年3 月15日公開之US2012/0000000A1「用於形成具有粗糙表面之發光二極體之光學對準

方法」專利案，其公開日早於系爭專利申請日（103年9 月24日），可為系爭專利相關之先前技術。

—證據4 揭示一用於在光微影製程中製作LED 時使一晶圓對位之對位系統，該LED 具有一λLED 之LED 光波長。該系統包含一晶圓，該晶圓具有一經過粗糙化的對位標記，該對位標記具有一RMS(均方根）表面粗縫度σS ，該設備具有一用於將光罩的對位標記與該（晶圓）經過粗糙化的對位標記的影像彼此重疊的鏡頭。該經粗糙化的對位標記的影像係利用具有一光波長λA 之對位光線所形成，光波長λA 的範圍介於大約2 σS 至約8 σS 之間。一影像感測器偵測該重疊之影像。一影像處理單元處理該經檢知之重疊影像以計算該晶圓與該光罩之間的一對準偏移量（見舉發卷第9頁；中文譯文，見本院卷2第34頁）。

（五）參證1 為補強原舉發證據證明力之補強證據，非審理法第33條所稱之新證據：

1.按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，智慧財產案件審理法第33條第1 、2 項定有明文。上開條文所指之新證據係就同一撤銷理由（即系爭專利是否違反核准時專利法第26條第3 、4 項規定，及請求項1 至20是否具有進步性）所提之新證據，但對於補強上開證據證明力之補強證據，則非上開條文所規範，除有礙訴訟終結之情形外，自得於事實審

言詞辯論終結前隨時提出（行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第196 條參照），行政法院就補強證據自應盡上開調查證據，認定事實之職責（最高行政法院107 年度判字第163 號判決意旨參照）。

2.原告主張：參加人於行政階段提出之參證1 係為主張系爭專利請求項所述雷射雕刻、該標記反射光線、產生電壓值（訊號）等技術特徵，為教科書所列之通常知識，故參證1 係審理法第33條第1 項所稱新證據，而參加人「非」屬審理法第33條第1 項之當事人，故不得提出該參證1 新證據云云（見本院卷2 第39頁）。惟查：

－參證1 即五南圖書出版股份有限公司2012年9 月出版之「光學與光電導論」節影本、復漢出版社民國74年8 月出版之「雷射加工技術」節影本、中央圖書出版社民國74年出版之「雷射工程導論」等教科書，又參加人提出上開證據，係用以佐證原處分及訴願決定所認所屬技術領域中具有通常知識者經由參照證據1 後得以輕易完成本案系爭專利之創作資料的補充證據一節，此有卷附行政參加答辯（二）狀1 份可稽（見本院卷1 第397-398 頁），且據參加人訴訟代理人於本院陳述明確（見本院卷1 第429 、431 頁；見本院卷2 第93頁）。

—所謂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」，係指具有申請時該發明所屬技術領域之「一般知識（general knowledge ）」及「屘通技能（ordinary skill）」之人，且能理解、利用申請時之先前技術。其中，「一般知識」，係指包括工具書或教科書等所載

之周知（well-known）的知識，亦包括屘遍使用（commonly used ）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。而「屘通技能」，則指執行例行工作、實驗的屘通能力。「一般知識」及「屘通技能」則簡稱「通常知識」。可知，原處分以及訴願決定所述之內容已依其「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」的通常知識（即包括了教科書所載之周知的知識）經由原舉發證據1 至4 的判斷，已瞭解該技術領域的技術水準，從而依據該等舉發證據而認定系爭專利請求項5-7 不具進步性，而參加人只是將教科書（即參證1 ）所載之周知知識輔助說明而已，故參證1 並非參加人另提之獨立新證據，而係原舉發的證據補強之用，易言之，參證1 並非參加人本於同一舉發基礎事實（不具進步性）所另提之獨立新證據，僅係作為補強原舉發證據證明力之補強證據，自非審理法第33條所稱「新證據」，揆諸前揭判決意旨，本院就參證1 之補強證據自應盡調查證據，認定事實之職責。

- 原告主張：最高行政法院108 年度判字第211 號判決（下稱：211 號判決）意旨，揭明用以佐證發明所屬技術領域之通常知識的書籍，為審理法之「新證據」云云（見本院卷2 第40-41 、102 頁）。惟查，211 號判決認「依參證2 即Blasse教授等於西元1994年出版「Luminescent Materials 」一書所示，該書係介紹發光材料之相關理論，自可用以佐證於系爭專利優先權日（即85年7 月29日），該發明所屬技術領域之通常知識。」（見判決理由六、（二）、1 ），實係

肯認參加人得於訴訟程序中提出「補強證據」以佐證所屬技術領域之通常知識。至於原告援引之「原判決認在本件被上訴人作成舉發成立之審定，而由專利權人即上訴人循序提起行政訴訟之情形，仍應准許參加人（即舉發人）提出新證據，而依審理法第33條第1項規定將組合證據7 及參證2 之新證據納入審理範圍，即非適法」（見判決理由六、（六）），則係該判決另指摘原審有組合證據7 及參證2 ，而將參證2 作為新證據之情形，可知，211 號判決並非認定佐證發明所屬技術領域之通常知識的書籍即為新證據，原告上開主張，不無誤解割裂211 號判決理由，而有悖於判決全文意旨，尚無可取。

（六）證據1 、2 之組合，可以證明系爭專利請求項5 不具進步性：

1.系爭專利請求項5 為獨立項，關於系爭專利請求項5 與證據1 、2 之技術內容，均如前述。

2.證據1 說明書第0002段揭示用於極紫外光（EUV ）曝光裝置之標線保護構件，包含一標線載體3 （相當於「具有標記之極紫外光光罩盒」）（見舉發卷第32頁背面）。又證據1 說明書第0054段及圖3 （見舉發卷第31頁背面、第37頁背面）揭示該標線載體3 具有一淨化過濾箱2 ，該淨化過濾箱2 具有上蓋2a及下蓋2b，以形成一容置標線1 之空間；證據1 圖4 揭示該淨化過濾箱2 放入一曝光裝置19中。再者，證據1 說明書第0087段及第0088段揭示在標線1 、上蓋2a及下蓋2b上，分別設置有位置測定用之「位置量測標記26」、「位置量測標記25」

及「位置量測標記27」（相當於「標記」），且對應設置於曝光裝置中之淨化過濾箱開啟工具18中之「位置量測裝置29」、「位置量測裝置28」及「位置量測裝置30」（相當於「感測器」）（見舉發卷第29頁，中文譯文，見本院卷2 第22-23 頁）。可知，系爭專利請求項5所揭示光罩盒之盒體、標記、加工機台之感測器等技術特徵，已為證據1 之標線載體3 、位置量測標記25至27及感測裝置位置量測裝置28至30所揭露，因此，證據1已揭示系爭專利請求項5 「一種具有標記之即紫外光光罩盒，其包含：一光罩盒體；以及至少一標記，其設置於該光罩盒體；其中該光罩盒體放入一加工機台，該加工機台之至少一感測器辨識該至少一標記」等技術特徵。

3.證據1 雖未直接揭示系爭專利請求項5 界定「該至少一標記係利用雷射雕刻方式形成於該光罩盒體，該至少一標記具有一表面粗糙度，該至少一標記之表面粗糙度介於0um 到2.00um之間，該加工機台之該至少一感測器產生一光線，該光線照射該至少一標記，該至少一標記反射該光線，該至少一標記反射後之該光線所產生之電壓值係依據該至少一標記之表面粗糙度」等技術特徵。然查：

－證據1 說明書第0088段以及第0090段揭示了一位置量測裝置28被提供用以偵測該位置量測標記25的位置，一位置量測裝置29被提供用以偵測該位置量測標記26的位置，一位置量測裝置30被提供用以偵測該位置量測標記27的位置，其中「位置量測裝置28」、「位置

量測裝置29」及「位置量測裝置30」，相當於系爭專利之「感測器」，而該位置量測標記25,26,27之影像具有像十字之形狀（cross-like shape），可藉由光學顯微鏡以二維取像裝置接受，以此偵測該位置量測標記25,26,27在X 方向及Y 方向上之位置（見舉發卷第29頁，中文譯文，見本院卷2 第23、24頁）。因此，證據1 說明書第0090段已具體指出位置量測標記25,26,27之影像，可藉由光學顯微鏡以二維取像裝置擷取，可見光學顯微鏡接收來自位置偵測標記之反射光線，使二維取像裝置進行取像工作，而其中光學顯微鏡以二維取像裝置擷取，也是因為標記本身的粗糙度可以不需要太大。基此，證據1 雖未具體揭示系爭專利請求項5 所界定的「該至少一標記之表面粗糙度介於0um 到2.00um之間」之技術特徵，惟系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據1 具有像十字之形狀的標記僅具有微細的結構，自可理解「該至少一標記之表面粗糙度介於0um 到2.00um之間」之技術特徵，可依使用者的需求而做設定，即可達成；佐以，系爭專利說明書第0022段記載「……表面粗糙度與相對應之反射光產生之電壓成反比，但本創作並不限定其表面粗糙度，表面粗糙度之大小係依據使用者之需求做設定，而其反射光產生之電壓也會隨表面粗糙度之大小而改變」（見舉發卷第73頁背面），顯然標記的表面粗糙度與機台偵測到由該表面反射之光線產生的訊號（即電壓）強度有關聯，而表面粗糙度是可依使用者之需求設定，藉以產生不同的電壓強度。是

以，系爭專利請求項5 所界定的「該至少一標記之表面粗糙度介於0um 到2.00um之間」係屬依使用者的需求而做的設定，故系爭專利請求項5 相對於證據1 ，並未產生無法預期之功效。

—系爭專利說明書第0010段及第0012段記載「本創作之目的之一，在於提供一種具有標記之極紫外光光罩盒，其至少一標記透過雷射雕刻方式形成於光罩盒體，以改變對應加工機台之至少一感測器的極紫外光光罩盒之至少一區域的表面粗糙度，使一光線受到至少一標記反射後之反射光所產生之電壓值維持一定範圍內，以便於日後加工機台之定位」、「再者，該至少一標記係利用雷射雕刻方式所形成，該至少一標記具有一表面粗糙度」（見舉發卷第74頁）。是以，系爭專利所欲解決問題，在於光罩盒上刻出一具有一粗糙度之標記，以便於加工機台以機器視覺識別其位置，是以，系爭專利請求項5 所請係為「具有標記之極紫外光光罩盒」，其係屬於「物」之創作，故其記載「利用雷射雕刻方式」之製造方法，乃是界定會在標記上形成有表面粗糙度，以便加工機台定位，而「雷射雕刻方式」所產生的技術特徵係為要使「該至少一標記之表面粗糙度介於0um 到2.00um之間」，此經參酌參證1 所示復漢出版社於74年8 月出版之「雷射加工技術」第119 至120 頁揭露利用雷射加工製作「標記」，「最適於在微小化的電子零件或機械零件等標記製造編號、型名等」，且提出兩種雷射標誌的實例，中央圖書出版社於74年出版之「雷射工程導論」第442

、443 頁提及「利用雷射在工件表面的極細聚焦光點及極高的峰值功率來蒸發去除表面部分材料，而達到雷射在工件（或商品）上的刻標誌及商標，稱為雷射標誌。…最小的可達1mm2內刻10個以上的字。」（見本院卷1 第401-416 頁），顯見，系爭專利請求項5所載以雷射雕刻形成標記之技術，乃教科書所列之習知通常知識。故所屬技術領域中具有通常知識者，在面臨一標記之表面粗糙度之數值的問題時，參酌證據1 所揭示之具有像十字之形狀的標記僅具有微細的結構，及補強證據參證1 揭示之通常知識內容，即可依使用者的需求做設定而達成解決粗糙度之數值，益徵，證據1 可達成系爭專利之功效，故系爭專利請求項5 相對於證據1 並未產生無法預期之功效。

. 原告主張：系爭專利請求項5 所載的粗糙度具有無法預期的功效云云（見本院卷2 第48-49 頁）。惟查，系爭專利說明書僅指出由機台上的感測器發出光線照射標記，再由標記反射該光線至感測器，由接收反射光之感測器產生一定範圍之電壓值，並未記載系爭專利請求項5 所載表面粗糙度數值，與習知的其他表面粗糙度所界定的各種數值，有何產生無法預期的功效，況且，原告係認系爭專利請求項5 的技術特徵可使微影機台精準辨識該光罩盒是否位於正確位置之目的，然證據1 摘要已記載該裝置是要使得光罩可正確地放置在該曝光裝置中，故證據1 亦教示了該等裝置中的標記是用以達到正確對位的功效。是以，證據1 已教示了系爭專利請求項5 的技術特徵，則所屬技術領

域中具有通常知識者，依其所揭露者之教示內容僅需簡單變更，即可輕易完成系爭專利請求項5 之發明，故系爭專利請求項5 相較於證據1 並未產生無法預期之功效，證據1 可以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

4.證據1 、2 具有組合動機：

證據2 所為一種光罩檢知裝置，其屬於檢測用於極紫外光微影製程的光罩的技術。又證據2 說明書第0036段（見舉發卷第22頁）及圖7A至7C揭示該光罩上有兩個標記18，該二標記18包含兩個小凹陷區19，且證據2 說明書第0080段揭示「以基準標記18當作光罩基底片M 上的座標的參考，所測得的缺陷位置可基於基準標記18之相對性座標所界定」（見舉發卷第21頁背面，中文譯文，見本院卷2 第28頁），證據2 說明書第0083段揭示「用於形成該基準標記之方法不限於前述，亦可採用例如以下之方式：形成一多層膜ML在一平坦的基板表面上，然後以FIB （Focused Ion Beam）或短波雷射照射該多層膜ML而獲致該基準標記」（見舉發卷第21頁背面，中文譯文，見本院卷2 第28頁）。雖然證據2 所揭示的該多層膜ML於基板上形成，再用短波雷射照射該多層膜而獲致該基準標記，但證據2 圖7C亦已揭示了多層膜ML連同光罩基板（MS）均因雷射照射而形成凹陷之標記，其仍已教示了利用雷射照射的方式形成標記係屬於所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成的技術。準此，證據1 與證據2 同樣揭露標記定義位置的技術手段，其功能與作用具有共通性，則系爭專利創作所屬技術領域中具有

通常知識者，在面臨光罩盒如何藉由至少一感測器接收該光罩盒體所反射之光線，以確定該至少一感測器已對應該至少一標記之定位位置問題時，自有合理動機參考證據1 、2 之技術內容，依其所揭露者之教示或建議予以簡單應用或組合，而能直接且無歧異得知其組合後之結構對應關係，而輕易完成系爭專利請求項5 之創作。

5.綜上，系爭專利請求項5 相較於證據1 、2 亦未產生無法預期之功效，整體觀之，系爭專利請求項5 為所屬技術領域具有通常知識者依證據1 、2 之組合即能輕易完成，而證據1 已可以證明系爭專利請求項5 不具進步性，業如前述，則證據1 、2 之組合，亦可以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

6.原告主張：系爭專利請求項5 「利用雷射雕刻方式」屬於會影響系爭專利請求項5 之「結構特徵」的技術特徵，即不同的表面處理技術，會產生不同的表面形貌及表面粗糙度，不得視為習知技術之運用云云（見本院卷1 第84-86 頁）。惟查：

－按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，核准時專利法第58條第4 項定有明文，依同法第120 條規定，於新型專利準用之。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術

領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍（最高行政法院106 年度判字第634 號、107 年度判字第154 判決意旨參照）。查依系爭專利說明書第0010段及第0012段前揭記載，可知，系爭專利創作的目的係在於：於光罩盒上刻出一具有一粗糙度之標記，以便於加工機台以機器視覺識別其位置，而系爭專利請求項5 所記載之利用雷射雕刻方式也是在界定會在標記上形成有表面粗糙度，以便加工機台定位。又系爭專利說明書中並未提及系爭專利的創作是因為利用雷射雕刻方式所產生的形貌，而使得系爭專利的創作有何不同於先前技術的特徵，縱認系爭專利所使用的雷射雕刻方式，可以產生特殊的形貌，惟依據申請時之系爭專利的說明書、申請專利範圍及圖式內容，雷射雕刻的方式所產生的形貌為何，並非系爭專利所欲創作的目的，原告上開主張，不無自行擴張解釋而將系爭專利實施例所示特徵視為限制條件而讀入請求項5 之範圍，尚無可採。

—原告雖主張依專家意見書（即甲證3 ），雷射雕刻所形成標記之表面形貌具有傳統加工難以達到的精密結構特徵云云（見本院卷1 第184-186 頁）。然查，系

爭專利說明書已明確說明本案創作的主要技術特徵是在於在標記上形成特定範圍的表面粗糙度，而系爭專利請求項5 所界定的特定數值範圍的表面粗糙度，相較於先前技術並不會產生無法預期的功效，已如前述，又依雷射雕刻方法，雖然可形成特殊的形貌，惟如前所述，參酌參證1 所示教科書之內容，利用雷射雕刻方式使得一表面達到一所欲的特定範圍之表面粗糙度係為習知的技術，且系爭專利請求項5 所請的標的係為「物」的專利，其特徵應在於物本身，即使未有參證1 的資料，所屬技術領域中具有通常知識者，仍可輕易完成系爭專利請求項5 之發明。從而，系爭專利請求項5 之「結構特徵」的技術特徵，依系爭專利說明書所載之創作的目的主要是利用「雷射雕刻方式」產生特定的表面粗糙度，而非特殊的表面形貌，故原告前揭主張「利用雷射雕刻方式」會影響精密結構特徵云云，尚無可採。

7.原告主張：系爭專利請求項並非「以製法界定物之請求項」，且無論依「專利審查基準」或「專利侵權判斷要點」，系爭專利請求項5 所載「雷射雕刻」的製法，對於請求項界定之範圍具有限定作用云云（見本院卷1 第187-188 頁、本院卷2 第42-46頁）。惟查：

－按所謂「以製法界定物之請求項」，可分為兩種類型：第一類係「純粹的」製法界定物之請求項，亦即「請求之物僅以其製法予以界定的請求項」；第二類係「不純的」製法界定物之請求項，亦即「請求之物的至少部分以其製法予以界定的請求項」。本件系爭專

利請求項5 的界定方式，係屬於「不純的」製法界定物之請求項，其仍然屬於「以製法界定物之請求項」甚明。原告上開主張系爭專利請求項5 所載「雷射雕刻」並非只申請標的「光罩盒」整體之製造方法，而是指光罩盒體形成「標記」的製法特徵，並非「以製法界定物之請求項」云云，即無可採。

—被告於105 年2 月公布的「專利侵權判斷要點」係在作為判斷某一專利與被控侵權物（方法）間之比對方式參考資料，並非用以作為專利的有效性判斷之準則，合先敘明。又本案為舉發案既屬於專利之有效性的判斷，則參照專利審查基準第二篇第三章「2.5.1 以製造方法界定物之請求項」規範，以製法界定物之請求項，其是否具有新穎性或進步性並非由製法決定，而是由該物本身決定。因此，對於物之請求項所載之「製法」技術特徵，其新穎性、進步性之判斷應視該技術特徵對物本身之結構是否產生影響，若無影響，縱使所請之物與先前技術以不同之製法所形成，亦無法據以認定所請之物具有新穎性或進步性。再者，參照2017年版專利審查基準第五篇第一章「4.3 實體要件之爭執」之規範：若方法之非結構特徵不會改變或影響結構特徵，可認定不具進步性，依此判斷原則，系爭專利請求項5 雖界定標記形成方法為利用「雷射雕刻」之加工方式，但「雷射雕刻」之加工方式並不具限定的作用，僅是要使得該標記之結構實際上以「表面粗糙度介於0um 到2.00um」之技術特徵而已，原告上開主張，並無理由。

8.原告主張：新型專利之非結構特徵應考量是否隱含申請專利之新型具有適用於該非結構特徵的某種特定結構，而系爭專利請求項5 的「利用雷射雕刻方式」及「標記反射後之該光線所產生的電壓值係依據該至少一標記之表面粗糙度」係隱含系爭專利之新型具有某種特定結構云云（見本院卷1 第184-187 頁），惟查：系爭專利請求項5 所記載之「利用雷射雕刻方式」，其係屬於以製法界定物之界定方式記載，非屬於用途界定物之界定方式，已如前述。又系爭專利請求項5 所記載之「標記反射後之該光線所產生的電壓值係依據該至少一標記之表面粗糙度」，該記載內容僅係描述所請極紫外光光罩盒應用於微影製程中之電壓值量測方式，實與「極紫外光光罩盒」本身結構完全無涉。再者，系爭專利說明書第0022段記載「……表面粗糙度大小係依據使用者之需求做設定，而其反射光之電壓也會隨表面粗糙度之大小而改變」（見舉發卷第73頁背面），可知，「電壓值」係偵測光線入射標記所產生之反射光後再經轉換而獲致之數值，使用者可依其需求而自定表面粗糙度大小以獲致不同之電壓值，換言之，入射光線及標記表面粗糙度決定偵測所得之電壓值，電壓值並無法影響標記表面粗糙度之結構，更無隱含標記之結構特徵。是以，原告主張電壓值限定標記表面粗糙度，其對標記之結構有所影響云云，亦無可取。

（七）證據1 、2 、3 之組合，可以證明系爭專利請求項5 不具進步性：

1.證據1 及證據1 、2 之組合，均可以證明系爭專利請求

項5 不具進步性，已如前述。又證據3 說明書第0073段揭示對位標記的表面粗糙度高度差須足以使涉入知光線被以漫射之方式而反射（見舉發卷第11頁、第12頁背面，中文譯文，見本院卷2 第32頁），且證據3 說明書第0066段揭示「偵測器9 可為任何本領域中已知之偵測器，像是感光耦合元件（CCD ）相機、位置感應偵測器（PSD ）或四元檢測器（Quad Cell ）」（見舉發卷第12頁背面，中文譯文，見本院卷2 第31頁），可知，感光耦合元件（CCD ）為本發明領域之習知技術，其主要係將光照射在一陣列電容上使電容陣列曝光，並將該電荷轉換為電壓信號，以供後續處理。故證據3 同樣已教示了「該至少一標記反射後之該光線所產生之電壓值係依據該至少一標記之表面粗糙度」之技術特徵。再者，證據3 說明書第0017段（見舉發卷第14頁背面）揭示其為適用於極紫外光微影製程的裝置與製造方法以及定位用標記，其與證據1 及2 具有技術領域的關聯度，且同樣揭露利用標記對位之技術手段，而與證據1 及2 的功能與作用具有共通性，則系爭專利創作所屬技術領域中具有通常知識者，在面臨光罩盒如何藉由至少一感測器接收該光罩盒體所反射之光線，以確定該至少一感測器已對應該至少一標記之定位位置問題時，自有合理動機參考證據1 、2 、3 之技術內容，依其所揭露者之教示或建議予以簡單應用或組合，而能直接且無歧異得知其組合後之結構對應關係，而輕易完成系爭專利請求項5 之創作。

2.綜上，系爭專利請求項5 相較於證據1 、2 、3 亦未產

生無法預期之功效，整體觀之，系爭專利請求項5 為所屬技術領域具有通常知識者依證據1 、2 、3 之組合即能輕易完成，故證據1 、2 、3 之組合，亦可以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

（八）證據1 、2 、4 之組合，可以證明系爭專利請求項5 不具進步性：

1.證據1 ，證據1 、2 之組合，證據1 、2 、3 之組合，均可以證明系爭專利請求項5 不具進步性，已如前述。又證據4 揭露「……該光罩具有一經過粗糙化的對位標記，該標記具有一RMS(均方根）表面粗糙度σS ；一鏡頭經設定用以重疊該光罩對位標記之影像與該經過粗糙化的對位標記的影像，該經過粗糙化的對位標記的影像係利用具有範圍為大約2 σS 到大約8 σS 的一波長λA 的對位光波所形成……」之技術特徵（見舉發卷第3頁，中文譯文，見本院卷2 第36頁），且證據4 說明書第0049段揭示讓經過粗糙化的對位標記的影像形成的對位光波的波長可為1um 至2um 之技術特徵（見舉發卷第4 頁背面，中文譯文，見本院卷2 第35-36 頁）。由此可推知於系爭專利說明書第0049段的實施例中對位光波的波長為1um 至2um 的情形下，此時對位標記的表面粗糙度σS 係為1um 至2um 的1/2 至1/8 ，即0.125um 至1um 之間。因此，不論系爭專利說明書已記載表面粗糙度之大小，可依據使用者之需求做設定，且依證據4 前開揭露之內容，亦可認定系爭專利請求項5 界定之表面粗糙度數值為介於0um 到2um 之間，係屬習知的技術。再者，證據4 說明書第0002段揭示了有關於光微影製程

製作電子元件LED（見舉發卷第5頁），其與證據1及2具有技術領域的關聯度，且同樣揭露利用標記對位之技術手段，其與證據1及2的功能與作用具有共通性，則系爭專利創作所屬技術領域中具有通常知識者，在面臨光罩盒如何藉由至少一感測器接收該光罩盒體所反射之光線，以確定該至少一感測器已對應該至少一標記之定位位置問題時，自有合理動機參考證據1、2、4之技術內容，依其所揭露者之教示或建議予以簡單應用或組合，而能直接且無歧異得知其組合後之結構對應關係，而輕易完成系爭專利請求項5之創作。

2.綜上，系爭專利請求項5相較於證據1、2、4亦未產生無法預期之功效，整體觀之，系爭專利請求項5為所屬技術領域具有通常知識者依證據1、2、4之組合即能輕易完成，故證據1、2、4之組合，亦可以證明系爭專利請求項5不具進步性。

（九）證據1、2之組合、證據1、2、3之組合；證據1、2、4之組合，可以證明系爭專利請求項6不具進步性：

－系爭專利請求項6係依附請求項5之附屬項，其權利範圍包括請求項5之全部技術特徵，並進一步界定「其中該至少一標記之反射後之該光線所產生之電壓值介於4.80伏特與5.20伏特之間」之附屬技術特徵。又證據1、2之組合；證據1、2、3之組合；證據1、2、4之組合，可以證明系爭專利請求項5不具進步性，已如前述。

—系爭專利請求項6所進一步界定之附屬技術特徵與「極紫外光光罩盒」本身之結構無關，應屬「非結構特徵」

，且並無改變或影響極紫外光光罩盒之結構特徵。又系爭專利請求項6 界定「電壓值介於4.80伏特與5.20伏特之間」之附屬技術特徵，亦是依據標記之表面粗糙度而形成，故系爭專利請求項6 所界定之附屬技術特徵，仍為所屬技術領域中具有通常知識者，參酌本案先前技術內容之組合而可輕易完成。因此，證據1 、2 之組合；證據1 、2 、3 之組合；證據1 、2 、4 之組合，均可以證明系爭專利請求項6 不具進步性。

（十）證據1 、2 之組合、證據1 、2 、3 之組合；證據1 、2 、4 之組合，可以證明系爭專利請求項7 不具進步性：

－系爭專利請求項7 係依附請求項5 之附屬項，其權利範圍包括請求項5 之全部技術特徵，並進一步界定「其中該至少一標記之反射後之該光線所產生之電壓值在3-sigma 等級規範下之標準差浮動控制於0.1 以內」之附屬技術特徵。又證據1 、2 之組合；證據1 、2 、3 之組合；證據1 、2 、4 之組合，均可以證明系爭專利請求項5 不具進步性，已如前述。

—系爭專利請求項7 界定之附屬技術特徵與「極紫外光光罩盒」本身之結構無關，且未改變或影響極紫外光光罩盒之結構特徵，應屬「非結構特徵」。故系爭專利請求項7 界定之附屬技術特徵，仍為所屬技術領域中具有通常知識者，參酌本案先前技術內容之組合而可輕易完成。因此，證據1 、2 之組合；證據1 、2 、3 之組合；證據1 、2 、4 之組合，均可以證明系爭專利請求項7 不具進步性。

（十一）原告其餘主張之論駁：

原告另主張：系爭專利反射光電壓量測方式與證據1 所揭示十字標記攝像方式，兩者技術迥異，且系爭專利相較於證據1 ，可達到精密度較高之定位云云（見本院卷1 第189-190 頁），並提出甲證3 之專家意見書1 份為憑（見本院卷1 第197-243 頁）。惟查，前開專家意見書（參甲證3 ）第4 頁末段指稱「本新型專利之反射光電壓量測方式屬於精密雷射光量測技術，係利用雷射光照射於特定標記上產生恆定光訊號的技術」，然而，系爭專利說明書與請求項5 至7 係記載由機台上的「感測器」產生光線以照射標記，再由標記反射該光線，反射後的該光線產生一電壓值，並未記載以「雷射光照射於特定標記上產生恆定光訊號」之技術特徵，亦即，系爭專利請求項5 係界定使用「感測器」產生光線以照射標記，而非界定為利用「雷射光」照射標記，前開意見書所載之技術內容，並未完整呈現專利範圍，其據與證據1 比對技術內容，自有違誤。況且，系爭專利請求項5至7 所述該標記反射光線、產生電壓值（訊號）、電壓值標準差（穩定度）等特徵，僅屬於量測技術，均非影響系爭專利所請「極紫外光光罩盒」結構之技術特徵。是以，原告此部分主張，亦無可採。

九、綜上所述，證據1 、2 之組合或證據1 、2 、3 之組合或證據1 、2 、4 之組合，均可以證明系爭專利請求項5-7 不具進步性。從而，被告以系爭專利請求項5-7 違反核准時專利法第120 條準用第22條第2 項規定不具進步性，而為「請求項5 至7 舉發成立，應予撤銷。」部分之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違

誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分關於請求項5 至7 舉發成立部分之審定，為無理由，應予駁回。

十、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　25　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　黃珮茹

法　官　張銘晃

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。

	2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合　、　之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出　所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　26　　日

書記官　葉倩如